آزمایش ثبت منحنی پسماند هسته آهنی یک ترنسفورماتور

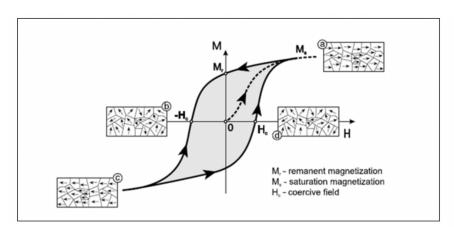
آزمایش شماره شش (بخش سوم) – آزمایشگاه فیزیک حالت جامد گروه ۲: پارسا رنگریز – عرفان ریاضی – ابراهیم خالقیان ۲۰ اردیهشت ۱۴۰۱

چکیده

هدف از انجام این آزمایش ترسیم منحنی پسماند یک ماده فرومغناطیسی است که هسته آهنی یک ترانسفورماتور میباشد و این منحنی توسط دستگاه چاپگر دوبعدی رسم شده است.

مقدمه

فرومغناطیسها موادی هستند که می توانند مغناطیس دائم داشته باشند و همچنین عمدتا وجود آنها تأثیر زیادی بر میدان مغناطیسی دارد. مواد فرومغناطیس خطی نیستند و در نتیجه روابط $\mu=\mu$ و $\mu=\mu$ و $\mu=\mu$ با مقدارهای ثابت $\mu=\chi$ در موردشان صدق نمی کند. در حالت کلی روابط μ به صورت $\mu=\mu$ برقرار است. در بررسی یک نمونه فرومغناطیس یا مغناطیده، اگر شدت مغناطیسی که در آغاز صفر است به صورت یکنوا افزایش داده شود، منحنی حاصل از رسم رابطه $\mu=\mu$ مشابه شکل $\mu=\mu$ خواهد بود. این منحی را منحنی مغناطیسی ماده می نامند. واضح است که $\mu=\mu$ هایی که با استفاده از رابطه $\mu=\mu$ بدست می آیند همواره علامتی یکسان (مثبت) دارند ولی مقادیر شان بسیار متفاوت است. بیش ترین مقدار تراوایی در زانویی منحنی رخ می دهد. علت وجود زانو در منحنی این است که مغناطیس مقادار بیشینه ای می رسد و برای مقادیر بسیار زیاد $\mu=\mu$ افزایش میدان مغناطیسی $\mu=\mu$ تنها بعلت وجود μ ادامه می بابد. مقدار بیشینه μ را «مغناطیس اشباع» ماده می نامند.



شكل ١: منحنى پسماند مغناطيسى

همانطور که در شکل ۱ دیده می شود، اگر شدت مغناطیسی H را کاهش دهیم، رابطه B-H از روی منحنی شکل بالا برنمی گردد، بلکه از روی منحنی جدید شکل زیر حرکت می کند و به نقطه M_r می رسد. مغناطیس پس از برقرار شدن دیگر با جذب H از میان

نمی رود. در واقع باید یک شدت مغناطیسی معکوس به کار گرفته شود تا مغناطیس به صفر کاهش یابد. اگر افزایش H در جهت معکوس ادامه یابد، آنگاه μ در جهت معکوس برقرار شده، حالت تقارن منحنی آغاز خواهد شد. سرانجام وقتی بار دیگر H افزایش یابد، نقطه در عمل در شکل منحنی پایینی را طی می کند. پس منحنی H وقتی H در حال افزایش است، با وقتی که H در حال کاهش است، کاملا متفاوت است. این پدیده را «پسماند» می گویند. مغناطیس در واقع از یک میدان محرک عقب می ماند. مقدار H در نقطه H را پسماند می گویند. اندازه H در نقطه H به نیروی وادارندگی و یا وادارندگی مغناطیس ماده موسوم است.

اگر از سیم پیچی به طول l و تعداد دور n_l جریان l عبور کند، میدان مغناطیسی ایجاد شده به صورت $H=rac{In_l}{l}$ خواهد شد. در عین حال القای مغناطیسی B نیز ایجاد می شود که برابر با $B=\mu_0\mu_r$ که $B=\mu_0\mu_r$ نفوذ پذیری مغناطیسی خلا و μ_r نفوذ پذیری نسبی است.

در این آزمایش، هسته آهنی یک ترانسفورماتور به عنوان ماده فرومغناطیس به کار میرود. با اعمال جریان متغیر به سیمپیچ اولیه H محور H نترل، شدت میدان مغناطیسی H پدید می آید. در نتیجه در نمودار بدست آمده H محور H خواهد بود و H محور H منبع تغذیه قابل کنترل، شدت میدان مغناطیسی H پدید می آید. و برگشت مغناطیسی H که با انتگرال گیری ولتاژ H که در حین تغییر و برگشت مغناطیسی سیمپیچ ثانویه تر نست می آید. پس بر طبق قانون القای مغناطیسی H است که در آن H سطح مقطع هسته و H تعداد دور سیمپیچ ثانویه می باشد. از انتگرال گیری زیر که توسط میکروولت متر انجام می گیرد، H بدست می آید:

$$\int_0^t U(t)dt = -nA\Delta B$$

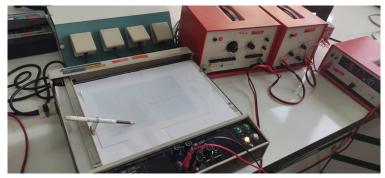
وسائل آزمایش

منبع جریان قابل کنترل، میکروولت متر، مولد تابع D، هسته U شکل، سیم پیچ $n_1=1000$ و $n_2=125$ دور، دستگاه چاپگر دوبعدی.

روش آزمایش

تنظيمات لازم قبل شروع:

دستگاه آزمایش را مطابق شکل ۲ سوار کنید و اتصالات لازم را برقرار سازید.



شکل ۲: پیکربندی دستگاهها جهت آزمایش

• تنظیم دستگاه چایگر یا ثبت کننده

ابتدا باید مبدا مختصات را برای حرکت مداد بر روی کاغذ رسم (برگه میلی متری) در دستگاه چاپگر مشخص کنیم. بدین منظور y میکروولت متر و مولد تابع باید در این مرحله خاموش باشند و با استفاده از پتانسیومترهای روی دستگاه، مداد را در راستای x و y آنقدر جابجا کنید تا در وسط برگه میلی متر قرار بگیرد و نقطه شروع رسم منحنی پسماند از این مبدا باشد.

• تنظیم صفر میکروولتمتر

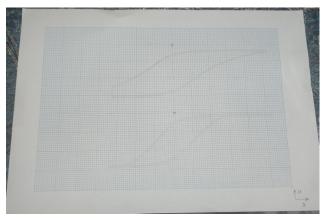
بعد از روشن کردن میکروولت متر، تقریبا ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس میکروولت متر را روی ضریب تقویت ۱۰ و حالت V قرار دهید. دهید. منبع جریان را روشن کرده و روی مقدار V۰ آمپر تنظیم کنید. دستگاه مولد تابع را روشن کرده و دامنه V0 را صفر کنید. افست افست V0 را فشار داده و سپس با پتانسیومتر میکروولت متر را روی صفر تنظیم کنید. بعد از تنظیم صفر میکروولت متر، کلید افست را خاموش کنید و میکروولت متر را به حالت V0 تغییر دهید و مولد تابع را روی V1 هر تز گذاشته و دامنه V1 ماکزیمم کنید.

در این آزمایش از یک ترانسفورماتور استفاده می کنیم که سیم پیچ اولیه آن به مولد جریان متناوب و تشدید کننده متصل است. میکروولت متر ولتاژ سیم پیچ ثانویه را به ΔB تبدیل می کند. منحنی پسماند را به ازای فرکانس های مختلف برای مولد و با استفاده از چاپگر رسم می کنیم.

نتيجه گيري

با رسم نمودار پسماند هسته آهنی به موارد زیر می پردازیم:

۱) نمودار پسماند با تغییرات فرکانس تغییر شکل میدهد؛ به این صورت که با افزایش فرکانس، نمودار بسته و لاغرتر می شود و این به آن مربوط است که پسماند کمتری رخ میدهد. مطابق شکل ۳ که در نمودار بالا فرکانس ۰/۱ هر تز و در نمودار پایین فرکانس ۰/۳ هر تز اعمال شده است، این مساله مشخص است.



شکل ۳: نمودار پسماند هسته آهنی بر حسب دو فرکانس مختلف ۰/۱ هرتز (بالا) و ۰/۳ هرتز (پایین)

۲) حوزه مغناطیسی به اسپینهای نزدیک و همسایه گفته می شود که در یک صفحه از اسپینها، جهت منظمی به خود می گیرند و با تغییر
میدان ممکن است جهت گیری آنها تغییر کند و حتی باعث ایجاد یا عدم ایجاد این حوزهها شود.

۳) برای مغناطشزدایی یک فرومغناطیس، کافی است آن را گرم کنیم. با افزایش دما و تحریک اسپینها، میتوان حوزهها را شروع به نوسان کرد و بدین صورت است که خاصیت تصادفی گرمایی باعث مغناطشزدایی میشود.

۴) مقدار القای پسماند مغناطیسی در H=0، هنگامی رخ می دهد که نمودار محور x را قطع می کند. با توجه به نمودار این مقدار برای فرکانس ۱/۱ هرتز برابر است با:

$B = 1.8 \ mT$, $M = 1.43 \times 10^3 \ A/m$

۵) همچنین در شدت میدان زیر، آهن خاصیت خود را از دست میدهد. این مقدار همانی است که نمودار پسماند محور y را قطع می کند.

$H = 1.6 \, mA/m$

۶) اشباع مغناطیسی هنگامی رخ میدهد که آنقدر میدان مغناطیسی قوی است که دیگر مغناطش تحمل پیروی از میدان را برای افزایش نداشته باشد و بدین صورت شار مغناطیسی شروع به کاهش کند. به این وضعیت اشباع مغناطیسی گفته می شود.

۷) مقدار القای پسماند آهن نسبت به فرکانس کاهش می یابد که این معلول لاغرتر شدن نمودار پسماند بر حسب افزایش فرکانس است.
دلیل این کاهش این است که مقدار زمان موثر انتگرال گیری پتانسیل کاهش می یابد.